

**Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Х.М. БЕРБЕКОВА»
ИНСТИТУТ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ**

Государственное казенное научное учреждение
«АКАДЕМИЯ НАУК ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»



«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ПОВЕРХНОСТИ»

Материалы Международной научно-практической конференции

г. Грозный 19 мая 2021 г.

Грозный – 2021 г.

УДК 538.9
ББК 94+22.3

Ответственный редактор:

Кутуев Р.А., к.ф.-м.н., доцент, проректор по общим вопросам ФГБОУ ВО «Чеченского государственного университета»

Редакционная коллегия:

Дадашев Р. Х., д.ф.-м.н.,
Алчагиров Б. Б., д.ф.-м.н.,
Горбенко Е. Е., д.ф.-м.н.,
Умхаева З. С., д.ф.-м.н.,
Хоконов М. Х., д.ф.-м.н.,
Малышевский В. С., д.ф.-м.н.,
Хаджимурадов М. А., д.ф.-м.н.,

Элимханов Дж. З., к.ф.-м.н.,
Хасанов А. И., к.ф.-м.н.,
Хасбулатов С. В., к.ф.-м.н.,
Алихаджиев С. Х., к.ф.-м.н.,
Алиев И. М., к.ф.-м.н.,

Современные методы исследования и диагностики поверхности. Материалы Международной научно-практической конференции (Грозный, 19 мая 2021 г.). – Грозный: издательство ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 2021. – 138 с.

В настоящем сборнике представлены материалы международной научно-практической конференции «Современные методы исследования и диагностики поверхности», состоявшейся 19 мая 2021 г. в г. Грозный.

Программа конференции включала работу секций «Физика конденсированного состояния», «Физическая электроника», «Теплофизика и теоретическая теплотехника». Статьи посвящены основным проблемам и перспективам развития информационных технологий, а также результатам научных исследований участников конференции.

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и методиками, научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования в научной работе. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.

ISSN 978-5-91127-298-2

СОДЕРЖАНИЕ

Умхаева З.С., Илюшин А.С., Алероева Т.А., Терешина И.С., Панкратов Н.Ю.	
Исследование ас-восприимчивости сплавов системы Sm(Tby)Fe2 в области температуры магнитного фазового перехода.....	5
Алчагиров Б.Б., Хибиев А.Х., Канаметова О.Х., Дышекова Ф.Ф., Коков З.А.	
К определению поверхностного натяжения жидких металлов методом большой лежащей капли: влияние механических колебаний на результаты измерений.....	12
Горбенко Е.Е., Пилипенко Е.А.	
Влияние трехчастичного взаимодействия на фононные частоты кристаллического криптона в модели деформируемых атомов.....	18
Хоконов М.Х., Бекурова И.З., Ломаносов В.С.	
Излучение ультрарелятивистских электронов и позитронов при канализации в кристаллах и полях мощных лазеров.....	26
Кара-Мурза С.В., Корчикова Н.В., Техтелев Ю.В., Жидель К.М., Павленко А.В.	
Эллипсометрия тонких пленок ниобатов бария-стронция.....	36
Павленко А.В., Зинченко С.П. Ковтун А.П., Толмачев Г.Н., Киселева Л.И., Стрюков Д.В., Матяш Я.Ю.	
Особенности сегнетоэлектрического состояния в поликристаллических тонких пленках BA0.5SR0.5NB2O6 на подложке (001) SI.....	43
Матиев А.Х., Успажиев Р.Т.	
Фазовые переходы в кристаллы TlGaSe2.....	48
Сайпулаева Л.А., Мельникова Н.В., Тебеньков А.В., Бабушкин А.Н., Риль А.И., Маренкин С.Ф., Захвалинский В.С.	
Отрицательное магнитосопротивление в CdAs2 при высоком давлении.....	50
Андрюшин К.П., Смотраков В.Г., Андрюшина И.Н., Еремкин В.В., Резниченко Л.А.	
Теплофизические свойства высокотемпературных и анизотропных материалов с участием PBTIO3.....	56
Хасбулатов С.В., Андрюшин К.П., Омаров З.Х., Резниченко Л.А.	
Диагностика теплофизических свойств мультиферроика феррита висмута, модифицированного редкоземельными элементами.....	60
Мустафаев Г.А., Мустафаев А.Г., Хасанов А.И., Черкесова Н.В., Мустафаев А.Г.	
Влияние характеристик отмычочных жидкостей на степень очистки кремниевых пластин.....	65
Мустафаев Г.А., Мустафаев А.Г., Хасанов А.И., Черкесова Н.В., Мустафаев А.Г.	
Формирование малоразмерных контактов на основе слоя вольфрама.....	70
Шомахов З.В., Налимова С.С.	
Исследование состава поверхности легированных наностержней оксида цинка.....	75
Джамбулатов Р.С.	
Экспериментальные исследования свойств поверхности в системе вода-ацетон-диоксан и боковых двойных системах.....	80
Калмыков Р.М., Кармоков А.М., Лысенко А.Г., Хасанов А.И.	
Электронно-микроскопические исследования матрицы PbTe с примесями CdSe.....	85
Дышекова А.Х., Кармоков А.М., Хасанов А.И.	
Состав и структура поверхности раздела монокристалла хлорида натрия и свинца.....	90
Афашагов А.А., Шебзухова М.А., Бжихатлов К.Ч.	
Поверхностное натяжение в двухкомпонентных металлических системах.....	95
Малкондуев Ю.А., Кокоева А.А.	
Сополимеры на основе N-винилпирролидона и галогенсодержащих соединений акриловых кислот.....	99

Мараева Е.В., Халугарова К., Мошников В.А.	
Композитные антибактериальные структуры на основе гидроксиапатита и оксида цинка.....	104
Калажоков З.Х., Гогия А.Р., Калажоков Х.Х., Зигалов А.Х., Мамиков Р.З.	
Оценка толщины поверхностного адсорбционного слоя бинарных сплавов щелочных металлов.....	110
Калажоков З.Х., Гогия А.Р., Калажоков Х.Х., Жамбеков А.Х.	
Оценка толщины поверхностного адсорбционного слоя δ_0 по данным РФЭС измерений.....	113
Кузамишев А.Г., Шебзухова М.А., Бжихатлов К.Ч.	
Размерная зависимость теплоты плавления наночастиц сферической формы на границе твердое-жидкость.....	116
Смирнов М.В., Сидоров Н.В., Палатников М.Н., Пикулев В.Б.	
Люминесценция с поверхности номинально чистых кристаллов ниобата лития разного генезиса.....	120
Джангаров А.И., Гишлакаев С.У.	
Цифровые технологии для мониторинга сельскохозяйственного процесса.....	126
Себаева З.Ш.	
Современные инновационные технологии преподавания курса физики в области образования.....	130

ВЛИЯНИЕ ТРЕХЧАСТИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ФОНОННЫЕ ЧАСТОТЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРИПТОНА В МОДЕЛИ ДЕФОРМИРУЕМЫХ АТОМОВ

Е.Е. Горбенко,

*кандидат физико-математических наук, доцент, директор Института физико-математического образования, информационных и обслуживающих технологий ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет», г. Луганск
e_g81@mail.ru*

Е.А. Пилипенко,

*кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела фазовых превращений ГУ ДНР «Донецкий физико-технический институт им. А.А.Галкина», г. Донецк
pilipenko.katerina@mail.ru*

Аннотация. В модели деформируемых атомов представлены *ab initio* расчеты фононных частот сжатого кристаллического Kr с учетом многочастичного взаимодействия. В потенциале отталкивания, наряду с трехчастичным взаимодействием, связанным с перекрытием электронных оболочек атомов, исследуются трехчастичные силы, обусловленные взаимной деформацией электронных оболочек соседних атомов в дипольном приближении. Показано, что учет деформации электронных оболочек атомов дипольного типа приводит к «размягчению» продольной моды в точках L и X, поперечной моды T_1 в направлении Σ и в точке L при больших сжатиях. Рассмотренные трехчастичные силы усиливают этот эффект. Получено хорошее согласие теоретических фононных частот с имеющимися их экспериментальными значениями при нулевом давлении.

Ключевые слова: кристаллы инертных газов, многочастичное взаимодействие, деформация электронных оболочек, высокое давление, фононные частоты, абсолютная неустойчивость.

INFLUENCE OF THREE-BODY INTERACTION ON THE PHONON FREQUENCIES OF CRYSTALLINE KRYPTON IN THE MODEL OF DEFORMABLE ATOMS

Ie.Ie. Gorbenko,

PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Director of the Institute of Physics and Mathematics Education, Information and Service Technologies of Lugansk State Pedagogical University, Lugansk

E.A. Pilipenko,

PhD in Physics and Mathematics, Senior Researcher, Department of Phase Transformations of Donetsk A.A. Galkin Institute for Physics and Technology, Donetsk

Abstract. *Ab initio* calculations of phonon frequencies of compressed Kr crystals have been performed taking into account the many-body interaction in the model of deformable atoms. In the short-range repulsive potential, along with three-body interaction associated with the overlap of the electron shells of atoms, the three-body forces generated by the mutual deformation of the electron shells of the nearest-neighbor atoms have been investigated in the dipole approximation. It is shown that the allowance for the deformation of the dipole-type electron shells of atoms in the pair and three-body approximations leads to softening of the longitudinal mode at the points L and X is observed, the transverse mode T_1 is softened in the direction Σ and at the point L at high compressions. This effect is enhanced by the three-body forces. There is a good agreement between the theoretical phonon frequencies and the experimental values at zero pressure.

Keywords: rare-gas crystals, many-body interactions, deformation of the electron shells, high pressure, phonon frequencies, absolute instability.

Введение

Кристаллы инертных газов (КИГ) – простейшие молекулярные кристаллы, которые удерживаются сравнительно слабыми силами Ван-дер-Ваальса, благодаря чему они используются в качестве стандартных тестовых объектов во многих теоретических исследованиях более сложных многофункциональных материалов [1-3]. КИГ являются первичной составляющей атмосфер звезд и планет. Их поведение в экстремальных условиях важно для понимания внутренней структуры, формирования и эволюции этих астрофизических объектов. Следовательно, изучение динамических свойств КИГ в условиях высокого давления представляет научный интерес.

Интенсивное экспериментальное изучение атомных свойств КИГ связано с развитием технологий, позволяющих в лабораторных условиях добиваться высоких давлений [4,5]. Применение для изучения фононных спектров метода неупругого рассеяния рентгеновских лучей (inelasticx-rayscattering – IXS) вместо спектроскопических методов неупругого нейтронного рассеяния дает возможность использовать технику ячеек алмазных наковален и поэтому расширить диапазон давлений до 100 GPa и выше [6].

Основная тенденция современных работ по *ab initio* расчетам на основе теории функционала плотности (density functionaltheory – DFT) заключается в том, чтобы как можно более точно описать слабосвязанные молекулярные комплексы системы инертных газов, видоизменяя обменно-корреляционный потенциал. Предполагается, что увеличение плотности заряда в результате сжатия приведет к улучшению используемых приближений. Следуя [7,8], это связано с тем, что DFT не способна рассчитать с достаточной точностью два вида дисперсионных сил: дальнодействующее взаимодействие Ван-дер-Ваальса и эффекты перекрытия в короткодействующем потенциале отталкивания. Следовательно, важно рассчитать широкий круг динамических характеристик сжатых КИГ из первых принципов в едином подходе, позволяющем получить как многочастичное взаимодействие в короткодействующем потенциале отталкивания, так и взаимодействие Ван-дер-Ваальса, которое представляет собой результат взаимного деформирующего и поляризующего действия атомов друг на друга.

На основе квантово-механической модели деформируемых и поляризуемых атомов (модель Толпиго) (см., например, [9]) в настоящей работе проводится *ab initio* расчет фононных частот и исследуется влияние трехчастичного взаимодействия в короткодействующем потенциале отталкивания и деформации электронных оболочек атомов в парном и трехчастичном приближениях на абсолютную неустойчивость в сжатом кристаллическом криптоне в широком интервале давления.

Расчет фононных частот с учетом трехчастичных сил и деформации электронных оболочек в дипольном приближении

В модели Толпиго потенциальная энергия решетки U получена путем нахождения \bar{H} по вариационным параметрам c_i^l и $c_{ij}^{ll'}$, описывающим слабую деформацию электронной волновой функции, при произвольных фиксированных смещениях ядер \mathbf{u}^l и произвольных дипольных моментах \mathbf{P}^l [9]

$$U = \min \bar{H} = \text{const} + \sum_l \left\{ \frac{(\mathbf{P}^l)^2}{2\alpha} + \boldsymbol{\beta}^l \cdot \mathbf{P}^l - \frac{1}{2} \sum_{l'} \frac{C}{|\mathbf{r}^{ll'}|^6} + \frac{1}{2} \sum_{l'} K(\mathbf{P}^l, \mathbf{P}^{l'}) + \frac{1}{2} \sum_{l'} U_{sr}(|\mathbf{r}^l - \mathbf{r}^{l'}|) \right\}. \quad (1)$$

Первые два слагаемые в (1) описывают деформацию электронных оболочек в дипольном приближении (где α – поляризуемость). Третье слагаемое дает силы Ван-дер-Ваальса. K –

кулоновское взаимодействие всех диполей \mathbf{P}^l между собой. Последнее слагаемое в (1) представляет короткодействующее отталкивание E_{sr} .

Уравнения колебаний решетки для смещений атомов \mathbf{u}^l и их дипольных моментов \mathbf{P}^l можно записать в виде:

$$m\ddot{u}_\alpha^l = -\frac{\partial U}{\partial u_\alpha^l}, \quad \frac{\partial U}{\partial P_\alpha^l} = 0, \quad (2)$$

где m – масса электрона.

[1] В [10]

предложен метод представления короткодействующего потенциала отталкивания E_{sr} в виде разложения по степеням малого параметра – интеграла перекрытия волновых функций электронов соседних атомов S .

$$[2] \quad E_{sr} = E^{(0)}(S^2) + W_2(S^2) + W_3(S^3) + W_4(S^4) + W_5(S^5) + W_6(S^6) \quad (3)$$

[3] В

выражении (3) первое $E^{(0)}$ и второе W_2 слагаемые содержат только одно- и двухцентровые интегралы и соответствуют парному взаимодействию. Слагаемое W_3 – представляет собой поправку третьей степени по S ; это слагаемое содержит трехцентровые интегралы и соответствует трехчастичным взаимодействиям. Поправка четвертой степени по S – W_4 – смешанного типа. Она состоит из одно-, двух-, трех- и четырехцентровых интегралов. Поправка пятой степени W_5 состоит только из трехцентровых интегралов, а поправка шестой степени W_6 – только из двухцентровых. Каждый из перечисленных интегралов умножается на S в соответствующей степени.

[4] Двухцентровые кулоновские интегралы точно рассчитаны на основе таблиц Клементи и Роетти [11]. Полученные при этом закономерности были использованы для аппроксимации трех- и четырехцентровых интегралов произведениями соответствующих интегралов перекрытия.

[5] Для случая, когда атомы l, l', l'' образуют равносторонний треугольник и при $S \ll 1$, трехчастичный потенциал W_3 можно привести к простой форме, а именно

$$[6] \quad W_3 = -\sum_{ll'l''} \left(S(r^{ll''}) \right)^2 f(r_1), \quad f(r_1) = \frac{S(r_1)}{r_1}, \quad r_1 = \left| \mathbf{r}^{l'} - \frac{1}{2} \mathbf{r}^{ll''} \right|, \quad (4)$$

где $S = S_{np,np_z}^{ll''}$ – наибольший из интегралов перекрытия между внешними np -орбиталами электронов. В отличие от парного потенциала $W_2(r^{ll''})$, трехчастичный потенциал W_3 зависит не только от $r^{ll''}$ и $r^{ll''}$, но и от $(\mathbf{r}^{ll''} \cdot \mathbf{r}^{ll''})$. Аргумент функции $f(r_1)$ представляет собой медиану рассматриваемого треугольника l, l', l'' . В данном случае $r_1 = r^{ll''} \cdot \cos \frac{\pi}{6} = a \frac{\sqrt{6}}{2}$.

Дифференцируя уравнения (2), подставляя все переменные $\mathbf{p}^l = e\mathbf{u}^l$, \mathbf{P}^l в виде плоских волн $\exp\{i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t\}$ и суммируя по $l'l''$, можно получить уравнения для амплитуд p_α, P_α с учетом рассмотренного трехчастичного взаимодействия.

В уравнениях колебаний решетки наряду с короткодействующими трехчастичными силами, обусловленными перекрытием электронных оболочек атомов [10], рассматриваем трехчастичное взаимодействие, обязанное деформации электронных оболочек [12]. Выражения для квадратов собственных частот в симметричных направлениях волнового вектора \mathbf{k} с учетом всех рассмотренных трехчастичных сил приведем в безразмерных переменных Ω и \mathbf{k} .

Для направления [001]:

$$\begin{aligned}\Omega_L^2 &= 2(G+H)(1-\cos k_z) + 2(F+E)\sin^2 k_z + B\chi_{zz} + \left[A_1 - \frac{(2h+2g)^2}{A^{-1}-\varphi_{zz}} \right] (1-\cos k_z)^2. \\ \Omega_T^2 &= (G+2H+V_t)(1-\cos k_z) + 2F\sin^2 k_z + B\chi_{xx} + \left[B_1 - \frac{(2h+g)^2}{A^{-1}-\varphi_{xx}} \right] (1-\cos k_z)^2.\end{aligned}\quad (5)$$

Для направления [111]:

$$\Omega_L^2 = (4G+3H+2E+6F+V_t)\sin^2 k_z + B(\chi_{xx}+2\chi_{xy}) + \left[A_2 - \frac{(3h+4g)^2}{A^{-1}-2\varphi_{xy}} \right] \sin^4 k_z. \quad (6)$$

$$\Omega_T^2 = (G+3H+2E+6F)\sin^2 k_z + B(\chi_{xx}-\chi_{xy}) + \left[B_2 - \frac{(3h+g)^2}{A^{-1}+\varphi_{xy}} \right] \sin^4 k_z.$$

Для направления [110]:

$$\begin{aligned}\Omega_L^2 &= (H+2G+2E+4F)\sin^2 k_z + (2H+G+V_t)(1-\cos k_x) + \\ &+ \left[C_1 - \frac{(h+2g)^2}{A^{-1}-\varphi_{xx}-\varphi_{xy}} \right] \sin^4 k_x + \left[C_2 - \frac{2(h+2g)(2h+g)}{A^{-1}-\varphi_{xx}-\varphi_{xy}} \right] (1-\cos k_x) \sin^2 k_z + \\ &+ \left[C_3 - \frac{(2h+g)^2}{A^{-1}-\varphi_{xx}-\varphi_{xy}} \right] (1-\cos k_x)^2 + B(\chi_{xx}+\chi_{xy}).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Omega_{T_1}^2 &= (H+2E+4F)\sin^2 k_x + (G+2H)(1-\cos k_x) + \\ &+ \left[D_1 - \frac{h^2}{A^{-1}-\varphi_{xx}+\varphi_{xy}} \right] \sin^4 k_x + \left[D_2 - \frac{2h(2h+g)}{A^{-1}-\varphi_{xx}+\varphi_{xy}} \right] (1-\cos k_x) \sin^2 k_x + \\ &+ \left[D_3 - \frac{(2h+g)^2}{A^{-1}-\varphi_{xx}-\varphi_{xy}} \right] (1-\cos k_x)^2 + B(\chi_{xx}-\chi_{xy}).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Omega_{T_2}^2 &= (H+4F+V_t)\sin^2 k_x + 2(G+H)(1-\cos k_x) + \\ &+ \left[F_1 - \frac{h^2}{A^{-1}-\varphi_{zz}} \right] \sin^4 k_x + \left[F_2 - \frac{4h(h+g)}{A^{-1}-\varphi_{zz}} \right] (1-\cos k_x) \sin^2 k_x + \\ &+ \left[F_3 - \frac{4(h+g)^2}{A^{-1}-\varphi_{zz}} \right] (1-\cos k_x)^2 + B\chi_{zz}.\end{aligned}\quad (7)$$

В выражениях (5)–(7) $H = H_0 + \delta H$, $G = G_0 + \delta G$, где $H_0(a\sqrt{2})$ и $G_0(a\sqrt{2})$ являются первой и второй производными короткодействующего парного потенциала отталкивания для равновесных расстояний первых соседей; аналогично для вторых соседей $F = H_0(2a)$ и $E = G_0(2a)$; B определяет взаимодействие Ван-дер-Ваальса; h и g – параметры деформации электронных оболочек атомов дипольного типа в парном приближении; $\chi_{xx}, \chi_{xy}, \chi_{xz}$ – функции \mathbf{k} , происходящие от ван-дер-ваальсовских сил; $\varphi_{xx}, \varphi_{xy}, \varphi_{xz}$ – коэффициенты электрического поля, вызванного системой диполей \mathbf{P}^l ; A – безразмерная поляризуемость атома [9]. Параметры δG , δH и V_t представляют собой трехчастичные короткодействующие силы, обусловленные перекрытием электронных оболочек (недеформированных) атомов [10]. Параметры A_i, B_i, D_i – трехчастичные силы, связанные со взаимной деформацией электронных оболочек. Эти слагаемые не дают новой зависимости от \mathbf{k} по сравнению с

рассмотренной ранее «парной» деформацией электронных оболочек в дипольном приближении. Параметры, необходимые для расчета фононных частот в зависимости от сжатия $u = \Delta V / V_0$ ($\Delta V = V(p \neq 0) - V_0$, где V_0 – объем при нулевом давлении) представлены в работе [12].

Расчет фононных частот Kr в широком интервале давлений

На рисунке 1 представлены рассчитанные нами фононные частоты для Kr при $p=0$. Для сравнения мы приводим результаты, полученные в работе [13] на основе расширенного потенциала Леннарда-Джонса и наши предыдущие расчеты [14] без учета трехчастичных сил. Согласие наших расчетов с экспериментом [15] хорошее. Видно, что результаты расчетов [13] хуже согласуются с экспериментом.

На рисунке 1 представлены фононные частоты $\hbar\omega_{\lambda k}$ в симметричном направлении волнового вектора \mathbf{k} для Kr при сжатии $u = 0.68$. Три группы кривых соответствуют трем вариантам расчетов $\hbar\omega_{\lambda k}$: в модели MT₀ учитывается трехчастичное взаимодействие за счет перекрытия электронных оболочек атомов ($\delta G \neq 0$, $\delta H \neq 0$, $V_t \neq 0$), но не рассматривается их деформация ($A_i = B_i = D_i = 0$, $g = h = 0$); в модели MT₁ добавляется учет деформации электронных оболочек в «парном» приближении ($A_i = \dots = D_i = 0$, $g \neq 0$, $h \neq 0$); в модели MT₂ учитываются все рассмотренные трехчастичные силы и деформация электронных оболочек атомов ($\delta G \neq 0$, $\delta H \neq 0$, $V_t \neq 0$, $A_i \neq 0 \dots D_i \neq 0$, $g \neq 0$, $h \neq 0$).

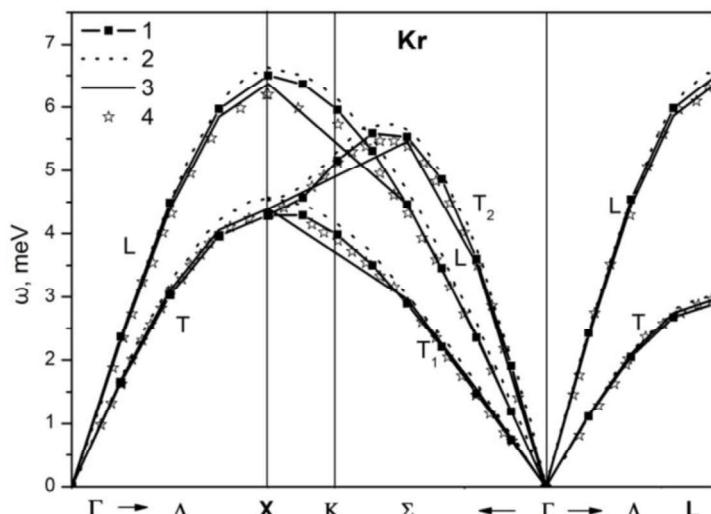


Рис. 1. Фононные дисперсионные кривые для Kr в симметричных направлениях волнового вектора \mathbf{k} при $p=0$. 1 – расчеты настоящей работы в модели MT₂ с учетом всех рассмотренных трехчастичных сил; 2 – расчет с расширенным потенциалом Леннарда-Джонса [13]; 3 – расчеты с учетом деформации электронных оболочек без учета трехчастичных сил (модель M3a) [14]. 4 – эксперимент [15].

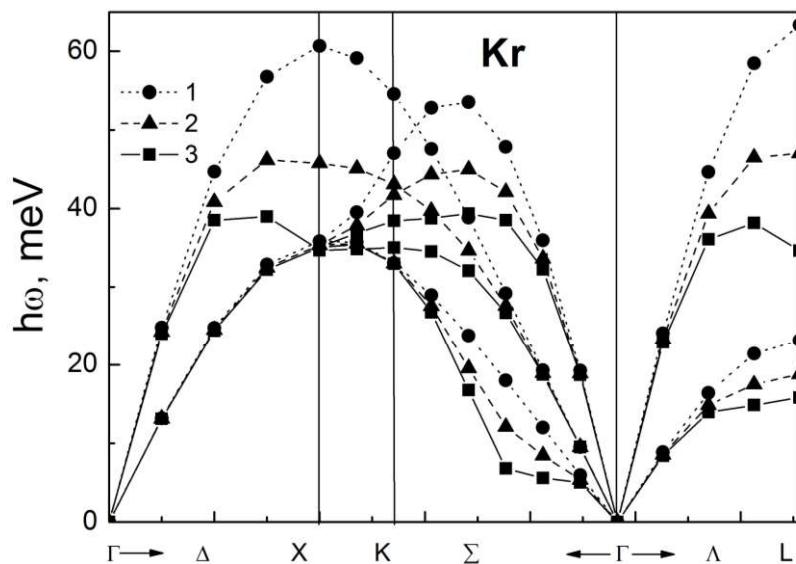


Рис. 2. Фононные дисперсионные кривые в симметричных направлениях волнового вектора \mathbf{k} для Kr при $u = 0.68$. Расчеты: 1 – в модели MT_0 ; 2 – в модели MT_1 ; 3 – в модели MT_2

Из рисунка 2 видно, что в продольной моде в точках X и L, поперечной моды T₁ в направлении [110] и вырожденной поперечной моды T в точке L присутствует «размягчение» фононных частот, что свидетельствует о динамической нестабильности Kr. Наибольшее «размягчение» получается при учете деформации электронных оболочек в парном и трехчастичном приближениях (модель MT_2).

В таблице 1 представляет численные значения $\hbar\omega_{\lambda k}$ при различном сжатии в тех точках зоны Бриллюэна, где визуально наблюдается наибольшее «размягчение» фононных частот. Сравнение моделей MT_2 и MT_0 (γ) показывает, что вклад деформации электронных оболочек в парном и трехчастичном приближениях увеличивается с ростом давления. В скобках даны результаты расчетов энергии фононов $\hbar\omega_{\lambda k}$ в модели M2 (без учета трехчастичных сил и деформации электронных оболочек) и в модели M2a (без трехчастичных сил, но с учетом деформации электронных оболочек в парном приближении) [16]. Сравнение значений фононных частот Kr ($u = 0.6$), полученных в моделях MT_0 и M2, показывает, что энергия фононов растет при включении трехчастичных сил, обязанных перекрытию электронных оболочек для всех сжатий. Результаты расчетов в моделях MT_2 и M2a показывают уменьшение $\hbar\omega_{\lambda k}$ при учете трехчастичных сил за счет деформации электронных оболочек, которое компенсируется ростом в модели MT_0 . Следовательно, получаются значения γ близкие к рассчитанным ранее с парным неэмпирическим потенциалом [16].

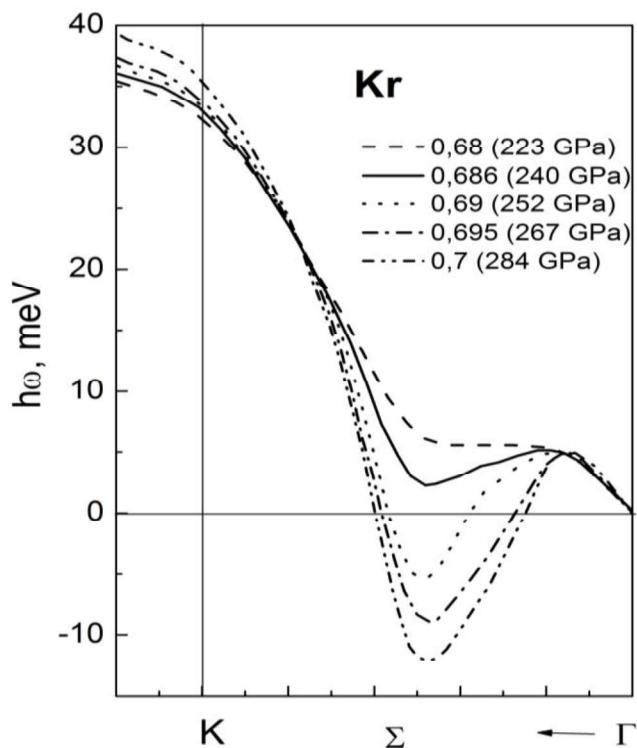


Рис. 3. Фононная дисперсия частот поперечной ветви T_1 в направлении Σ для Kr при различных сжатиях $u = \Delta V / V_0$ (давлениях P)

На рисунке 3 показано размягчение «критических» колебаний поперечной ветви T_1 в направлении Σ для Kr. Сплошная линия – рассчитанные минимальные значения $\hbar\omega_{\lambda k}(u)$ при указанных на рисунке 2 сжатиях. Будем считать эти сжатия и соответствующие им давления критическими p_c . При больших сжатиях частота становится мнимой. Из рисунка видно, что при давлениях больше критических $p > p_c$ и соответствующих им сжатиях равным 0.686 ($p_c=240$ GPa) для Kr $\hbar\omega_{\lambda k} \rightarrow 0$ и наступает абсолютная неустойчивость.

Таблица 1

Частоты $\hbar\omega_{\lambda k}$ [meV] в моделях MT₀(M2) и MT₂(M2a) и относительный вклад трехчастичного взаимодействия и эффектов деформации электронных оболочек γ [%] при различных степенях сжатия для КИГ в «критических» точках

Теория		$\hbar\omega_{\lambda k}$ в модели MT ₀ (M2)				$\hbar\omega_{\lambda k}$ в модели MT ₂ (M2a)				γ , %
Kr										
u		0.3	0.6	0.68	0.3	0.6	0.68	0.3	0.6	0.68
p , GPa	\mathbf{k}, λ	5.771	93.455	222.995	5.771	93.455	222.995	5.771	93.455	222.995
X [0;0;1]	L	15.220 (14.94)	42.390 (41.85)	60.684	14.577 (14.6)	33.198 (36.45)	34.671	4.22 (2.31)	21.68 (12.89)	42.87
	T	9.461 (9.77)	25.162 (26.23)	35.811	9.373 (9.62)	24.66 (26.6)	35.063	0.93 (1.45)	2 (1.4)	2.09
L[1/2;1/2;1/2]	L	15.504 (15.15)	43.965 (42.86)	63.337	14.807 (14.83)	33.889 (38.28)	34.627	4.49 (2.12)	22.92 (10.69)	45.33
	T	6.164 (6.19)	16.192 (15.65)	23.172	6.163 (6.18)	15.142 (15.96)	15.830	0.02 (0.18)	6.48 (1.98)	31.68
k [3/8;3/8;0]	T ₁	4.632	12.349	17.989	4.625	10.887	6.809	0.51	11.84	62.15

Примечание. $\gamma = [\left(\omega(MT_0) - \omega(MT_2) \right) / \omega(MT_0)] \cdot 100\%$. (В скобках даны значения частот рассчитанных в моделях M2 и M2a и соответствующие значения γ [16])

Заключение

Трехчастичные силы, за счет перекрытия электронных оболочек, малы как при нулевом, так и ненулевом давлении. Кроме этого, в настоящей работе оценивалась роль трехчастичных сил, обусловленных взаимной деформацией электронных оболочек. Эти эффекты оказались более значительными. Они ярко проявились в «размягчении» фононных мод в ГЦЦК-криптоне при соответствующих сжатиях.

Общий подход [17] к построению адиабатического потенциала U для КИГ позволяет выяснить наиболее важные взаимодействия в них. Обоснованная достаточно точная форма адиабатического потенциала, полученная ранее в предположении парного межатомного взаимодействия [18,19], была обобщена на случай для n -атомного взаимодействия [10]. Развитая теория позволяет вычислить короткодействующий потенциал отталкивания индивидуально для каждого кристалла ряда Ne-Xe с учетом многочастичного взаимодействия и деформации электронных оболочек атомов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Kwon I., Collins L.A., Kress J.D., and Troullier N. First-principles study of solid Ar and Kr under high compression // Phys.Rev.B. – 1995. – V.52. – P. 15165-15169.
2. Bucko T., Hafner J., Lebegue S., Angyan J. Improved Description of the Structure of Molecular and Layered Crystals: Ab initio DFT Calculations with van der Waals Corrections // J.Phys.Chem.A. – 2010 – V.114. – P. 11814-11824.
3. Tran F., Kalantari L., Traoré B., Rocquefelte X., and Blaha P. Nonlocal van der Waals functionals for solids: Choosing an appropriate one // Phys.Rev.Materials. – 2019. – V.3. – P. 063602-063604.
4. Hemley R.J. and Ashcroft H.K. The Revealing Role of Pressure in the Condensed Matter Sciences // Phys.Today. – 1998. – V.51. – N 8. – P. 26-32.
5. Shimizu H., Saitoh N., and Sasaki S. High-pressure elastic properties of liquid and solid krypton to 8 GPa // Phys.Rev.B. – 1998. – V.57. – P. 230-233.
6. Krish M. Status of phonon studies at high pressure by inelastic x-ray scattering // J. Raman Spectrosc. – 2003. – V.34. – P.628-632.
7. Schwerdtfeger P., Hermann A. Equation of state for solid neon from quantum theory // Phys.Rev.B. – 2009. V.80. P. 064106-064110.
8. Schwerdtfeger P., Steenbergen K.G., and Pahl E. Relativistic coupled-cluster and density-functional studies of argon at high pressure // Phys.Rev.B. – 2017. – V.95. – P. 214116-214120.
9. Троицкая Е.П., Горбенко Е.Е., Пилипенко Е.А. Многочастичное взаимодействие и деформация электронных оболочек атомов в динамике решетки сжатых атомарных криокристаллов // ФНТ. – 2016. – Т.42. – С. 526-537.
10. Троицкая Е.П., Чабаненко Вал.В., Жихарев И.В., Горбенко Е.Е. *Ab initio* теория многочастичного взаимодействия и соотношения Коши в сжатых кристаллах инертных газов //ФТТ. – 2011. – Т.53. – С. 1555-1563.
11. Clementi F., Roetti C. Roothan-Hartree-Fock atomic wave functions // At.Data Nucl.Data Table. – 1974. – V.14. – P. 177-478.
12. Троицкая Е.П., Чабаненко В.В., Горбенко Е.Е., Пилипенко Е.А. *Ab initio* теория многочастичного взаимодействия и фононные частоты кристаллов инертных газов под давлением в модели деформируемых атомов // ФТТ. – 2015. – Т.57. – С. 114-123.
13. Moyano G.E., Schwerdtfeger P., and Rosciszewski K. Lattice dynamics for fcc rare gas solids Ne, Ar, and Kr from *ab initio* potentials // Phys.Rev.B. – 2007. – V.75. P. 024101-024106.
14. Троицкая Е.П., Чабаненко В.В., Горбенко Е.Е. Элементарные колебания в кристаллах инертных газов: фононные частоты сжатых кристаллов ряда Ar-Xe // ФТТ. – 2006. –Т.48. – С. 695-699.
15. Skalyo J., Endoh Y., and Shirane G. Inelastic neutron scattering from solid krypton at 10 °K // Phys.Rev.B. – 1974. – V.9. – P. 1797-1803.

16. Троицкая Е.П., Чабаненко В.В., Горбенко Е.Е. Динамическая матрица и фононы в кристаллах инертных газов при высоких давлениях // ФТВД. – 2006. – Т.16. – № 1. – С. 25-37.
17. Троицкая Е.П., Чабаненко Вал.В., Жихарев И.В., Горбенко Е.Е., Пилипенко Е.А. Квадрупольная деформация электронных оболочек в динамике решетки сжатых кристаллов инертных газов // ФТТ. – 2012. – Т.54. – С. 1179-1186.
18. Zarochentsev E.V., Varyukhin V.N., Troitskaya E.P., Chabanenko Val.V., Horbenko E.E. Interatomic potential and elastic constants of rare-gas crystals under pressure // Phys.Stat.Sol.B. – 2006. –V.243. – Р. 2672-2686.
19. Зароченцев Е.В., Троицкая Е.П. Уравнение состояния кристаллов инертных газов вблизи металлизации // ФТТ. – 2001. – Т.43. – С. 1292-1298.

УДК 539.12/17 DOI: 10.36684/42-2021-1-26-35

ИЗЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАРЕЛЯТИВИСТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ И ПОЗИТРОНОВ ПРИ КАНАЛИРОВАНИИ В КРИСТАЛЛАХ И ПОЛЯХ МОЩНЫХ ЛАЗЕРОВ

М.Х. Хоконов,

доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической и экспериментальной физики, ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик

khokon6@mail.ru

И.З. Бекурова,

старший преподаватель кафедры теоретической и экспериментальной физики (глд), ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик

indbekul@mail.ru

В.С. Ломаносов,

аспирант,

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик

slavaloman@bk.ru

Аннотация. Изучены нелинейные эффекты в излучении ультраквантитативистских электронов в поле линейно-поляризованной интенсивной лазерной волны в сравнении с излучением при плоскостном канализировании позитронов в ориентированных кристаллах. Показано, что формулы для спектра излучения могут быть представлены в универсальной форме, которая определяется двумя Лоренц-инвариантами. Учитываются квантовые эффекты в излучении. Показаны и существенные отличия лазеров и ориентированных кристаллов, связанные с тем, что в последнем случае параметр недипольности излучения зависит от энергии позитронов.

Ключевые слова: мощные лазеры, ориентированные кристаллы, излучение при канализировании, параметр Швингера.

RADIATION OF ULTRA-RELATIVISTIC ELECTRONS AND POSITRONS DURING CHANNELING IN CRYSTALS AND IN THE FIELDS OF POWERFUL LASERS

М.Х. Ноконов,

Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Head of the Department of Theoretical and Experimental Physics, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education

"Kabardino-Balkarian State University named after Kh.M. Berbekov" Nalchik